PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7

H01B 1/06, H01M 6/18, C08L 83/05, 83/06

(11) 国際公開番号 A1 WO00/25323

(43) 国際公開日

2000年5月4日(04.05.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/05592

JP

(22) 国際出願日

1999年10月12日(12.10.99)

(81) 指定国 CN, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

(30) 優先権データ 特願平10/306234

1998年10月28日(28.10.98)

添付公開書類

国際調查報告書

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)鐘淵化学工業株式会社(KANEKA CORPORATION)[JP/JP]〒530-8288 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

| 岡田賢治(OKADA, Kenji)[JP/JP]

〒652-0872 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目2番80号 鐘淵化学工業株式会社 機能性材料RDセンター

神戸研究所内 Hyogo, (JP)

(74) 代理人

安富康男, 外(YASUTOMI, Yasuo et al.)

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番22号

リクルート新大阪ビル4階 Osaka, (JP)

(54) Title: CURABLE COMPOSITION FOR SOLID POLYMER ELECTROLYTE

(54)発明の名称 高分子固体電解質用硬化性組成物

(57) Abstract

A curable composition which gives a solid polymer electrolyte having high ionic conductivity and excellent mechanical strength. The composition comprises the following (A) to (D) as essential ingredients: (A) a polysiloxane having SiH groups (B) a compound which has at least one structure selected from the group consisting of a benzene ring, siloxy bond, carbonyl group, amide bond, and amino group and has two or more alkenyl groups (C) a hydrosilylation catalyst and (D) a salt compound electrolyte.

(57)要約

高いイオン伝導度を示し、機械的強度にも優れた高分子固体電解質を与える硬化性組成物を提供する。

下記(A)~(D)を必須成分とする高分子固体電解質用硬化性組成物である。

- (A) SiH基を有するポリシロキサン
- (B) ベンゼン環、シロキシ結合、カルボニル基、アミド結合、及びアミノ基からなる群より選ばれる少なくとも1つの構造を有し、かつ2個以上のアルケニル基を有する化合物
- (C) ヒドロシリル化触媒
- (D) 電解質塩化合物

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)
AE アラブ普及国連邦 DM ドミニカ KZ カザフスタン RU ロシア AM アルベニア EE エストニア LC セントルシア SD スペタニーデン AT オーストリア FI フィンシド LK リットランカ SG スクェニーア SS スクェニーア SS スクシェーデン SS スクシェーデン AT オーストリア FI フィンシド LK リットランカ SG シンロヴェニア SS I スロヴェニア SS I スロヴェーア SS I スロヴェーア SS I スロヴェーア SS I スロヴェーア TG ディン・ログェニア SS I スロヴェーア TG ディン・ログェニア SS I スロヴェーア TG ディン・ファーンド MA モロウョコ TG ディンド サイナ MA モロウョコ TG ディード MD モグリカー TG ディード MD モグリカー TG ディンド MD モグリカー TG ディンド・トバゴ TG ディンド・トバゴ TG アイブリカ HU インドネシア MN モーリタニア TG ディンド・トバゴ TG アイブランド MN モーリタニア US ディンド・トバゴ TG ディン・ジーランド NE エジェール VI MP マグド・トバゴ TG ディン・ジーランド NE エジェール VI ND ユニー・ジーランド CU キューバ JP B本 NL エー・ジーランド ZW ジンバブエ NO ユニー・ジーテンド RP 北朝鮮 PT ボルトガルル グンバブエ TG ディン・フェニア KF 北朝鮮 PT ボルトガルル PT ボルトガルル PT ボルトガルル PT ボルトガルル TG ディン・フェニーア TG ディン・フェニーア TG アイコココスラヴィア TG ディーコココスラヴィア TG アイニー・ジーテンド NO ニニー・ジーテンド TG アイココリカ共和国 アーニーア TG アンマーク KP 北朝鮮 PT ボルトガルル TG アーニーア TG アンアーフェニーア TG アンアーフェニーア TG アンアーフェニーア TG アンアーフェニーア TG アンアーフェーア TG アンアーフェーア TG アンアーフェーア TG アンアーフェーア TG アンアーフェーア TG アンド TG アンアーフェーア TG アンアーフェーア TG アンアーデース TG アンアード TG アンドード TG アンアード TG ア

明細書

高分子固体電解質用硬化性組成物

5 技術分野

本発明は、高分子固体電解質用硬化性組成物、並びに、これを用いてなる高分子固体電解質及び電池に関する。

背景技術

25

10 高分子電解質をリチウムイオン電池や電気化学的デバイスに使用していくため には、低温から高温の広い温度範囲で高いイオン伝導度を有し、結晶性を示さな いことなどが必要不可欠である。しかしながら、このような必要性能を総合的に 満足するような高分子電解質はこれまで開発されていない。

ポリマー電池などに使用する高分子電解質には、例えば、従来はプロピレンカ ・ボネート、エチルメチルカーボネートなどの有機溶剤が幅広く使用されている が、これらは沸点と蒸気圧の関係で一般に70~90℃が高温域での使用限界と なっている。

最近はこのような有機溶媒の安全性を改良する方法として、ポリエチレンオキシド(以下、PEOと記載する)を中心とした高分子電解質の研究が行われている。PEOは周期表 1 族又は 2 族に属する金属塩、例えば L i CF_3SO_3 、 L i ClO_4 、 $NaCF_3SO_3$ 、 L i L

従って低温で使用するような汎用性のある商品に組み込むことは困難であった。 低分子量PEOを用いてイオン伝導度を向上させる方法としてビニル系ポリマーの側鎖に低分子量PEOを導入する方法が、D. J. Banistarらによって、Polymer, 25, 1600 (1984) に報告されている。しかしながら、この高分子材料はLi塩と錯体を形成するものの、低温でのイオン伝導 度が不十分であった。

さらにポリシロキサンの側鎖に低分子量PEOを導入した材料が、Journal of Power Sourse, 20,327(1987)や特開昭63-136409号、特開平2-265927に記載されているが、イオン伝導度が不十分あるいは非晶質でない、合成処方が容易ではない、液状で加工性・成形性に劣る、機械的強度が不十分などの理由で実用化はされていない。

PEO側鎖とSiH基を有するポリシロキサンとポリエチレンオキサイドを主鎖に有するオレフィンとのヒドロシリル化架橋体化合物が特開平3-11535 9号に記載されているが、イオン伝導度が4.9×10⁻⁶S・cm⁻¹程度とかなり低いものであり満足のいくものではなかった。

発明の要約

5

10

本発明は、高いイオン伝導度を示し、機械的強度にも優れた高分子固体電解質を与える硬化性組成物を提供するものである。

- 15 本発明は、下記(A)~(D)を必須成分とする高分子固体電解質用硬化性組成物である。
 - (A) SiH基を有するポリシロキサン
 - (B) ベンゼン環、シロキシ結合、カルボニル基、アミド結合、及びアミノ基からなる群より選択される少なくとも1つの構造を有し、かつ2個以上のアルケニ
- 20 ル基を有する化合物
 - (C) ヒドロシリル化触媒
 - (D) 電解質塩化合物

また本発明は、上記高分子固体電解質用硬化性組成物より得られる高分子固体 電解質、及び、この高分子固体電解質を用いた電池でもある。

25

発明の詳細な開示

[A成分について]

本発明の(A)成分としては、SiH基を有するポリシロキサンであれば、従来公知のものを制限無く使用することが出来る。

25

- (A) 成分であるポリシロキサンは、ケイ素原子上の置換基として、ポリエチレンオキサイド構造含有基、環状カーボネート構造含有基、及び/又は、環状エーテル構造含有基を有し、なおかつSiH基を2個以上有するものであることが好ましい。
- 5 ここで、ポリエチレンオキサイド構造含有基とは、オキシエチレン単位を含有する1価の基であれば特に限定されず、オキシエチレン単位はケイ素原子に直接結合していてもよいし、2価の有機基を介して結合していてもよい。環状カーボネート構造含有基又は環状エーテル構造含有基とは、環状カーボネート又は環状エーテルを含有する1価の基であれば特に限定されず、環状カーボネート又は環 10 状エーテルはケイ素原子に直接結合していてもよいし、2価の有機基を介して結合していてもよい
 - (A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基としてポリエチレンオキサイド構造含有基を有するものである場合には、(A) 成分であるポリシロキサン中の全ケイ素原子数のうち10%~95%が、オキシエチレン単位の重合度が1~12であるポリエチレンオキサイド構造含有基を置換基として有することが好ましく、ポリシロキサン中の全ケイ素原子数のうち40%~90%が、オキシエチレン単位の重合度が1~12であるポリエチレンオキサイド構造含有基を置換基として有することがさらに好ましい。
- (A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基としてポリエチレ 20 ンオキサイド構造含有基を有する場合、(A) 成分は以下の構造で表されるもの であることが好ましい。

$$Me_{3}SiO \xrightarrow{\text{Me}} \text{SiO} \xrightarrow{\text{SiO}} SiMe_{3}$$

$$R \xrightarrow{n} (CH_{2})_{3}(OCH_{2}CH_{2})_{p}OCH_{3} \xrightarrow{m}$$

(式中、m、nはそれぞれ1以上の整数で、pは $1\sim12$ の整数である。Rは水素原子又は炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基を表し、nが2以上の場合、Rはそれぞれ同じでも異なっていてもよい。ただしRのうち少なくとも1つは水素原子であ

る。なお、m個ある繰り返し単位とn個ある繰り返し単位の並び方は順不同である。)

なお、本発明の(A)成分は分子中にSiH基を1個以上有するものであるが、 SiH基を2個以上有するものであること(すなわち上式中のRのうち少なくと も2つが水素原子であること)がより好ましい。

また (A) 成分が上式で表される場合には、以下に示すポリエチレンオキサイドの導入率 (%、以下Gで表す) が10%~95%であることが好ましく、40%~90%であることがさらに好ましい。

 $G = [m/(m+n+2)] \times 100$

20

25

10 (A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基としてポリエチレンオンオキサイド構造含有基を有する場合、ポリシロキサンの側鎖にポリエチレンオキサイド構造を有していることから(A) 成分の誘電率が高くなり、支持電解質を溶解、解離する能力に優れている。また主鎖にシロキサン構造を有していることからガラス転移温度が低く、イオンの移動を容易にしている。またこのようなのようなをある。それ合物は高温における安定性も高い。従って従来の高分子電解質では達成できなかった高温での劣化防止、低温における高イオン伝導性の発現が本発明によって達成される。

(A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基として環状カーボネート構造含有基を有する場合、(A) 成分は以下の構造で表されるものであることが好ましい。

$$\begin{array}{c|c} \text{Me}_{3}\text{SiO} & \begin{array}{c} \text{Me} \\ \text{SiO} \\ \text{R} \end{array} & \begin{array}{c} \text{SiO} \\ \text{Me} \end{array} & \begin{array}{c} \text{SiMe}_{3} \\ \text{m} \end{array}$$

(式中、m、nはそれぞれ1以上の整数である。Rは水素原子又は炭素数1~2 0の炭化水素基を表し、nが2以上の場合、Rはそれぞれ同じでも異なっていて もよい。ただしRのうち少なくとも1つは水素原子である。なお、m個ある繰り

返し単位と n 個ある繰り返し単位の並び方は順不同である。)

なお、本発明の(A)成分は分子中にSiH基を1個以上有するものであるが、 SiH基を2個以上有するものであること(すなわち上式中のRのうち少なくと も2つが水素原子であること)がより好ましい。

5 (A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基として環状エーテル構造含有基を有する場合、(A) 成分は以下の構造で表されるものであることが好ましい。

(式中、m、nはそれぞれ1以上の整数である。Rは水素原子又は炭素数1~2 0の炭化水素基を表し、nが2以上の場合、Rはそれぞれ同じでも異なっていて もよい。ただしRのうち少なくとも1つは水素原子である。なお、m個ある繰り 返し単位とn個ある繰り返し単位の並び方は順不同である。)

なお、本発明の(A)成分は分子中にSiH基を1個以上有するものであるが、 SiH基を2個以上有するものであること(すなわち上式中のRのうち少なくと も2つが水素原子であること)がより好ましい。

20 (A) 成分であるポリシロキサンが、ケイ素原子上の置換基として環状カーボネート構造含有基又は環状エーテル構造含有基を有する場合も、(A) 成分の誘電率が高くなり、支持電解質を溶解、解離する能力に優れている。また主鎖にシロキサン構造を有していることからガラス転移温度が低く、イオンの移動を容易にしている。またこのような高分子化合物は高温における安定性も高い。従って 25 従来の高分子電解質では達成できなかった高温での劣化防止、低温における高イオン伝導性の発現が本発明によって達成される。

本発明の(A) 成分であるポリシロキサンの重量平均分子量Mw(ポリスチレン換算)は $600\sim10000$ であることが好ましく、 $2000\sim1000$ 0であることがさらに好ましい。

[B成分について]

本発明の(B)成分としては、ベンゼン環、シロキシ結合、カルボニル基、アミド結合、及びアミノ基からなる群より選択される少なくとも1つの構造を有し、かつ2個以上のアルケニル基を有する化合物であれば、従来公知のものを制限無く使用することが出来る。(B)成分は、数平均分子量Mn [GPC(ポリスチレン換算)]が80~1000の範囲にあるものが好ましい。

(B) 成分として好ましいものとして、例えば、ビスフェノールAジアリルエーテル、2, 2'ージアリルピスフェノールA、ジアリルアミン、ジビニルベンゼン、ジアリルマレート、1, 3ージアリルウレア、ジアリルスクシネート、ジアリルカーボネート、ジアリルジカーボネート、ジアリルフタレート、1, 3ージビニルー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシラザン、アリル末端アクリルポリマーなどが挙げられる。

[C成分について]

10

- 15 本発明の(C)成分としては、ヒドロシリル化触媒であれば従来公知のものを制限無く使用することが出来る。
 - (C) 成分としては、白金化合物、ルテニウム化合物及びロジウム化合物からなる群より選ばれる少なくとも1種が好ましく、白金化合物であることがさらに好ましい。
- 20 (C) 成分として好ましいものとして、例えば、白金ビニルシロキサン、塩化 白金酸、Pt (COD) 2などが挙げられる。

[D成分について]

本発明の (D) 成分としては、電解質塩化合物であれば従来公知のものを制限 無く使用することが出来る。

25 (D) 成分としては、金属陽イオン、アンモニウムイオン、アミジニウムイオ ン、及びグアニジウムイオンからなる群より選ばれる陽イオンと、

塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、テトラフルオロホウ素酸イオン、硝酸イオン、AsF $_6$ -、PF $_6$ -、ステアリルスルホン酸イオン、オクチルスルホン酸イオン、ドデシルベンゼンスルホン酸イ

20

オン、ナフタレンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレンスルホン酸イオン、R 1 SO $_3$ -、(R 1 SO $_2$)(R 2 SO $_2$)N-、及び(R 1 SO $_2$)(R 2 SO $_2$)(R 3 SO $_2$)C- [各式中、R 1 、R 2 及びR 3 はそれぞれ電子吸引性基を示す。]からなる群より選ばれる陰イオンと

5 からなる化合物であることが好ましい。

また、 $R^1SO_3^-$ 、(R^1SO_2)(R^2SO_2)N⁻、及び(R^1SO_2)(R^2SO_2)(R^3SO_2)(R^3SO_2)(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO_3))(R^3SO_3)(R^3SO

- 10 (D)成分の金属陽イオンは、周期表1族又は2族に属する金属、遷移金属、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn及びAg金属から選ばれた金属の陽イオンであることが好ましく、Liの陽イオンであることが特に好ましい。
 - (D) 成分としては、具体的には、 $LiClO_4$ 、 $LiPF_6$ 、 $LiBF_4$ 、 $LiCF_3SO_3$ 、 $LiN(CF_3SO_2)_2$ 、又は $Li(C_2F_5SO_2)_2$ が特に好ましい。

本発明の高分子固体電解質用硬化性組成物において、(A)成分と(B)成分のモル比は0.01~5.0であることが好ましく、さらに好ましくは0.05~3.0である。(C)成分であるヒドロシリル化触媒は(B)成分の二重結合1モルに対して、0.00001~0.1モルであることが好ましく、さらに好ましくは0.0001~0.01モルである。

(D) 成分である電解質塩化合物は、高分子固体電解質用硬化性組成物1g中に0.01ミリモル~10ミリモル含有されることが好ましく、さらに好ましくは0.10ミリモル~5.0ミリモルの範囲である。

本発明の高分子固体電解質用硬化性組成物は、十分なイオン伝導度を有するが、 25 さらに高いイオン伝導度が必要な場合などには、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネートなどの可塑剤を添加させても良い。また更に高分子化合物、他の両親媒性化合物などを添加しても良い。

本発明の高分子固体電解質用硬化性組成物は、ヒドロシリル化反応により架橋 して、3次元網目構造を形成するものである。従って従来の高分子電解質で問題 であった流動性の防止、機械的強度の向上、加工性・成形性の向上を達成することが可能である。

[製造法等]

10.

15

25

本発明の(A)成分であるSiH基を有するポリシロキサンは、例えば以下に 示す方法で合成されるが、この方法に限定されるものではない。

ポリオルガノハイドロジェンシロキサンに対し、溶媒中、ヒドロシリル化触媒、末端オレフィンを有するポリエチレンオキサイドを滴下してヒドロシリル化させ、十分攪拌した後に、溶媒を減圧除去することにより、ポリエチレンオキサイド構造含有基を置換基に有するポリシロキサンを得る。ここで使用するポリシロキサンの重量平均分子量Mw(ポリスチレン換算)は、2000~10000であることが好ましい。ここで使用する溶媒は特に限定されるものではないが、好ましいものとしては、例えばトルエンなどが挙げられる。反応温度は特に限定されるものではないが、室温~100℃で実施されるのが好ましい。また添加する末端オレフィンを有するポリエチレンオキサイドとポリシロキサン中のSiH基の比率(オレフィン基/SiH基のモル比)は0.10~0.95の範囲にあるのが好ましい。さらには0.40~0.90の範囲にあるのが好ましい。特に好ましいのは0.50~0.85の範囲である。ヒドロシリル化触媒は特に限定されるものではないが、白金化合物、ロジウム化合物、ルテニウム化合物が好ましい。例としては、白金ビニルシロキサン、塩化白金酸などが挙げられる。

20 この製造方法は、バッチ法、セミバッチ法又は連続式で実施しうる。この反応 容器は、例えば連続的攪拌タンク反応容器でありうる。この方法はバッチ式ある いは連続式でおこなうのが好ましい。

このようにして得られた(A)SiH基を有するポリシロキサンに対して、(B)ベンゼン環、シロキシ結合、カルボニル基、アミド結合、及びアミノ基からなる群より選ばれる構造を有する2個以上のアルケニル基を有する化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、(D)電解質塩化合物を混合してから、加熱することにより高分子固体電解質用のフィルムを得ることができる。硬化反応の温度は特に限定されるものではないが、室温~150℃の範囲が好ましく、室温~120℃の範囲がさらに好ましい。特に好ましくは70℃から100℃の範囲が好ましい。

PCT/JP99/05592

本発明における高分子固体電解質用硬化性組成物の製造方法には特に制約はない。また反応容器の種類は重要でない。しかしながら副反応を防ぐため、非反応性材料で形成された反応容器中でおこなうのが好ましい。

本発明で示された高分子固体電解質用硬化性組成物を用いると、高分子の利点である可とう性を有して大面積薄膜形状の固体電解質が容易に得られる。例えば本発明で得られる高分子電解質を用いた電池の作製が可能である。この場合、正極材料として好ましいものとしては、例えばリチウムーマンガン複合酸化物、コバルト酸リチウム、五酸化バナジウム、ポリアセン、ポリピレン、ポリアニリン、ポリフェニレン・ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリピロール、ポリフラン、ポリアズレン、その他硫黄化合物などが挙げられる。負極材料として好ましいものとしては、例えばリチウム金属、リチウムがグラファイトあるいはカーボンの層間に吸蔵された層間化合物、リチウムー鉛合金などが挙げられる。また、本発明の高分子電解質の高い電気伝導性を利用して、アルカリ金属イオン、Cuイオン、Caイオン、及びMgイオンなどの陽イオンのイオン電極の隔膜として利用することも考えられる。

発明を実施するための最良の形態

次に本発明の実施例について具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限 定されるものではない。

20 (実施例1)

25

反応容器に、ポリメチルハイドロジェンシロキサン4g、トルエン約10g及び白金ビニルシロキサン1.2×10⁻³mmo1を加え、反応温度80℃で攪拌した。この混合物中に末端にアリル基を有する平均分子量約400のポリエチレンオキサイド24g(58mmo1)を滴下した。滴下終了から3時間後反応を終了させトルエンを減圧除去した。その結果、ポリエチレンオキサイドの導入率(ポリシロキサンの全ケイ素原子中での、ポリエチレンオキサイドを置換基として有するケイ素原子の割合)が74%のポリシロキサンが得られた。得られたポリエチレンオキサイド変性のポリシロキサン3.0gに、ビスフェノールAジアリルエーテル73mg(0.24mmo1)、白金ビニルシロキサン7.2×

 10^{-4} mmol及びLiClO₄108mg(1.0mmol)をTHF約1mlに溶解させたものを混合し、プレス機を使用して80Cで4時間加熱した。その結果無色透明の薄膜状物質を得た。この得られた薄膜状物質のイオン伝導度を、白金を電極とし、電圧0.5V、周波数範囲42Hz ~ 5 MHzの交流法を用い、複素インピーダンス法により算出した。その結果、25Cにおけるイオン伝導度は 1.5×10^{-4} S/cmであった。

(実施例2)

反応容器に、ポリメチルハイドロジェンシロキサン4g、トルエン約10g及 10 び白金ピニルシロキサン1.2×10⁻³mmolを加え、反応温度80℃で攪 拌した。この混合物中に末端にアリル基を有する平均分子量約400のポリエチ レンオキサイドを滴下した。滴下終了から3時間後反応を終了させトルエンを減 圧除去した。その結果、ポリエチレンオキサイドの導入率が74%のポリシロキ サンが得られた。得られたポリエチレンオキサイド変性のポリシロキサン3.0 g(x, 1, 3-i)(x-1, 1, 3, 3-i) + f(x-1, 1, 3, 3-i)- 15 (0. 23 mm o 1)、白金ピニルシロキサン1. 2×10⁻³ mm o 1及びL iClO4147mg (1.4mmol)をTHF約1mlに溶解させたものを 混合し、プレス機を使用して80℃で5時間加熱した。その結果無色透明の薄膜 状物質を得た。この得られた薄膜状物質のイオン伝導度を、白金を電極とし、電 圧0.5V、周波数範囲42Hz~5MHzの交流法を用い、複素インピーダン 20 ス法により算出した。その結果、25℃におけるイオン伝導度は2. 4×10⁻ ⁴S/cmであった。

(実施例3)

25 反応容器に、ポリメチルハイドロジェンシロキサン4g、トルエン約10g及 び白金ピニルシロキサン9.0×10⁻⁴mmolを加え、反応温度80℃で攪 拌した。この混合物中に片末端にアリル基を有する平均分子量約400のポリエチレンオキサイド18g(45mmol)を滴下した。滴下終了から5時間後反 応を終了させトルエンを減圧除去した。その結果、ポリエチレンオキサイドの導

入率が55%のポリシロキサンが得られた。得られたポリエチレンオキサイド変性のポリシロキサン3.0gに、ビスフェノールAジアリルエーテル91mg(0.30mmol)、白金ビニルシロキサン9.0×10 $^{-4}$ mmol及びLiCF $_3$ SO $_3$ 540mg(3.4mmol)をTHF約2mlに溶解させたものを混合し、プレス機を使用して85 $^{\circ}$ Cで8時間加熱した。その結果無色透明の薄膜状物質を得た。この得られた薄膜状物質のイオン伝導度を、白金を電極とし、電圧0.5 $^{\circ}$ C、周波数範囲42Hz $^{\circ}$ 5MHzの交流法を用い、複素インピーダンス法により算出した。その結果、25 $^{\circ}$ Cにおけるイオン伝導度は5.3×10 $^{\circ}$ 15/cmであった。

· 10

(比較例1)

上記実施例3で得られたポリエチレンオキサイドの導入率が55%のポリシロキサン3.0gに、トリエチレングリコールジビニルエーテル61mg(0.30mmol)、白金ビニルシロキサン9.0×10⁻⁴mmol及びLiCF₃SO3540mg(3.4mmol)をTHF約2mlに溶解させたものを混合し、プレス機を使用して85℃で10時間加熱した。その結果、硬化は全く進行しなかった。

(比較例2)

20 上記実施例 3 で得られたポリエチレンオキサイドの導入率が 5 5 %のポリシロキサン 3.0 gに、トリエチレングリコールジビニルエーテル 6 1 mg (0.3 0 mm o 1)、白金ビニルシロキサン 9.0 × 10⁻⁴ mm o 1 及び Li CF₃ SO₃ 1 7 0 mg (1.1 mm o 1)を THF約 1 m 1 に溶解させたものを混合し、プレス機を使用して 8 5 ℃で 8 時間加熱した。その結果無色透明の薄膜状物質を 得た。この得られた薄膜状物質のイオン伝導度を、白金を電極とし、電圧 0.5 V、周波数範囲 4 2 H z ~ 5 MH z の交流法を用い、複素インピーダンス法により算出した。その結果、25℃におけるイオン伝導度は 3.2 × 10⁻⁵ S/c mであった。

産業上の利用可能性

本発明の高分子固体電解質用硬化性組成物は加工性に優れ、また、本発明の高分子固体電解質用硬化性組成物より得られる高分子固体電解質は、イオン伝導度が高く、その温度依存性が小さく、さらに十分な機械強度を有するものである。

5 従って従来の高分子電解質で問題であった流動性の防止、機械的強度の向上、加工性・成形性の向上を達成することが可能である。

請求の範囲

- 1. 下記(A)~(D)を必須成分とすることを特徴とする高分子固体電解質用硬化性組成物。
- 5 (A) SiH基を有するポリシロキサン
 - (B) ベンゼン環、シロキシ結合、カルボニル基、アミド結合、及びアミノ基からなる群より選択される少なくとも1つの構造を有し、かつ2個以上のアルケニル基を有する化合物
 - (C) ヒドロシリル化触媒
- 10 (D) 電解質塩化合物
 - 2. (A) 成分であるポリシロキサンは、ケイ素原子上の置換基としてポリエチレンオキサイド構造含有基を有し、かつSiH基を2個以上有するものである請求項1記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。

15

- 3. (A) 成分であるポリシロキサンは、ケイ素原子上の置換基として環状カーボネート構造含有基を有し、かつSiH基を2個以上有するものである請求項1記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
- 20 4. (A) 成分であるポリシロキサンは、ケイ素原子上の置換基として環状エーテル構造含有基を有し、かつSiH基を2個以上有するものである請求項1記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
- 5. (A)成分であるポリシロキサン中の全ケイ素原子数のうち10%~9525 %が、オキシエチレン単位の重合度が1~12であるポリエチレンオキサイド構造含有基を置換基として有する請求項2記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
 - 6. (A) 成分であるポリシロキサン中の全ケイ素原子数のうち40%~90%が、オキシエチレン単位の重合度が1~12であるポリエチレンオキサイド構

· 5

造含有基を置換基として有する請求項5記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。

- 7. (C) 成分であるヒドロシリル化触媒は、白金化合物、ルテニウム化合物 及びロジウム化合物からなる群より選ばれる少なくとも1種である請求項1~6 のいずれか1項に記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
 - 8. (D) 成分である電解質塩化合物は、

金属陽イオン、アンモニウムイオン、アミジニウムイオン、及びグアニジウムイオンからなる群より選ばれる陽イオンと、

- 10 塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、 テトラフルオロホウ素酸イオン、硝酸イオン、 $A s F_6$ 、 $P F_6$ 、ステアリル スルホン酸イオン、オクチルスルホン酸イオン、ドデシルベンゼンスルホン酸イ オン、ナフタレンスルホン酸イオン、ドデシルナフタレンスルホン酸イオン、R 1SO_3 、 (R^1SO_2) (R^2SO_2) N 、及び(R^1SO_2)(R^2SO_2)(
- 15 R^3SO_2) C^- [各式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 はそれぞれ電子吸引性基を示す。] からなる群より選ばれる陰イオンと

からなる化合物である請求項1~7のいずれか1項に記載の高分子固体電解質用 硬化性組成物。

- 20 9. R¹、R²及びR³で示される電子吸引基は、同一又は異なって、炭素数が 1から6までのパーフルオロアルキル基又はパーフルオロアリール基である請求 項8記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
- - 11. 金属陽イオンはLiの陽イオンである請求項10記載の高分子固体電解 質用硬化性組成物。

- 12. (D) 成分である電解質化合物塩は、LiClO₄、LiPF₆、LiBF₄、LiCF₃SO₃、LiN(CF₃SO₂)₂、又はLi(C₂F₅SO₂)₂である請求項11記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
- 5 13. 金属陽イオンは、遷移金属の陽イオンである請求項8又は9記載の高分 子固体電解質用硬化性組成物。
 - 14. 金属陽イオンは、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn及びAg金属からなる群より選ばれる金属の陽イオンである請求項8又は9記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。
 - 15. (D) 成分である電解質塩化合物は、高分子固体電解質用硬化性組成物 1g中に0.10ミリモル~5.0ミリモル含有される請求項1~14のいずれ か1項に記載の高分子固体電解質用硬化性組成物。

- 16. 請求項1~15のいずれか1項に記載の高分子固体電解質用硬化性組成物より得られる高分子固体電解質。
- 17. 請求項1~16のいずれか1項に記載の高分子固体電解質用硬化性組成 20 物より得られる高分子固体電解質を用いた電池。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05592

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
	Cl' H01B 1/06, H01M 6/18, C08	L83/05, C08L83/06			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELD	S SEARCHED				
Minimum d	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)				
Int.	Int.Cl ⁷ H01B 1/06, H01M 6/18, H01M10/40, C08L83/05, C08L83/06, C08L101/12				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
JOIS		•	,		
DIAI	OG.				
CAS					
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.		
х	JP, 5-98169, A (Kanegafuchi Ch 20 April, 1993 (20.04.93),	em. Ind. Co., Ltd.),	1,7~17		
. Y	Par. Nos. [0001]-[0041], [0047]	-[0055]. [0058]-[0063].	2,4~17		
	[0070]-[0079] (Family: none)		2,4-17		
Y	JP, 2-24976, A (Hitachi Maxell	Ltd.),	2,5~17		
	26 January, 1990 (26.01.90),		2,5-1,		
	Claims (Family: none)				
Ÿ	US, 5091274, A (National Science	ce Council).	4,7~17		
	25 February, 1992 (25.02.92),		-,,		
	Claim & JP, 4-19903				
	a or, 4-19903				
T	JP, 11-302383, A (Kanegafuchi (Chem. Ind. Co., Ltd.),	3 · ·		
	02 November, 1999 (02.11.99),				
	Par. Nos. [0001]-[0018] (Fami	Ty: none)			
T	JP, 11-306856, A (Kanegafuchi (Chem. Ind. Co., Ltd.),	3		
	05 November, 1999 (05.11.99),		_		
	Par. Nos. [0001] - [0020] (Fami	ly: none)			
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: ant defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with th	rnational filing date or e application but cited to		
"E" carlier	red to be of particular relevance locument but published on or after the international filing	understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
"L" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone	ed to involve an inventive		
special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the c considered to involve an inventive step	laimed invention cannot be		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		combined with one or more other such combination being obvious to a person	documents, such		
"P" docume	nt published prior to the international filing date but later priority date claimed	"&" document member of the same patent fi	amily		
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			ch report		
01 F	ebruary, 2000 (01.02.00)	15 February, 2000 (1			
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01B 1/06, H01M 6/18, C08L83/05, C08L83/06 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01B 1/06, H01M 6/18, H01M10/40, C08L83/05, C08L83/06, C08L101/12 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) JOIS DIALOG CAS 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP, 5-98169, A (鐘淵化学工業株式会社), 20. 4月, 1993 (20. 04. 93), 【0001】 ~【0041】、【0047】 ~【0055】、【0058】 ~【0063】及び【0070】 ~【0079】 (ファミリーなし) X 20.4 1. $7 \sim 1.7$ Y $2.4 \sim 17$ JP, 2-24976, A (日立マクセル株式会社), 26.1月.1990(26.01.90), 特許請求の範囲(ファミリー Y $2, 5 \sim 17$ Y US, 5091274, A (National Science Council), 25. 2月. 1992 (25. 02. 92), Claim & JP, 4 4, $7 \sim 17$ -19903X C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 **論の理解のために引用するもの** 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 01.02.00 15.02.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 X 8414 日本国特許庁 (ISA/JP) 小川 進 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C(続き).	関連すると認められる文献	/ U3332
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
T	JP, 11-302383, A (鐘淵化学工業株式会社), 2. 11月. 1999 (02. 11. 99), 【0001】~【001 8】 (ファミリーなし)	3
Т	JP, 11-306856, A (鐘淵化学工業株式会社), 5. 11月. 1999 (05. 11. 99), 【0001】~【002 0】 (ファミリーなし)	3 ,
	8	
• * *		
		**
·		